**Фомина Лариса Валерьевна. Физико-химические аспекты формирования нанослоевых структур контактов Ir-GaAs n-типа в условиях халькогенной пассивации поверхности полупроводника и электрохимического осаждения металла : Дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 : Барнаул, 2003 180 c. РГБ ОД, 61:04-2/577**